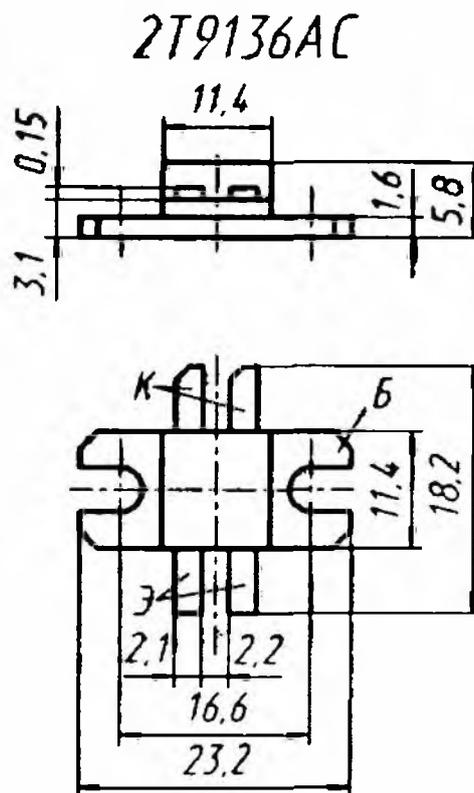


## 2Т9136АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально-планарных структуры  $n-p-n$  генераторных транзисторов. Предназначена для применения в импульсных генераторах, усилителях мощности в диапазоне частот 200...500 МГц в схеме ОБ при напряжении питания 45 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса сборки не более 7 г.



### Электрические параметры

Импульсная выходная мощность в двухтактной схеме на частоте  $f = 500$  МГц при  $U_n = 45$  В,  $P_{вх} = 71,4$  Вт,  $t_{и} = 250$  мкс,  $Q = 10$ ,  $T_k \leq +40$  °С, не менее ..... 500 Вт

Коэффициент усиления по мощности в двухтактной схеме на частоте  $f = 500$  МГц при  $U_n = 45$  В,  $P_{вх} = 71,4$  Вт,  $t_{и} = 250$  мкс,  $Q = 10$ ,  $T_k \leq +40$  °С, не менее ..... 7

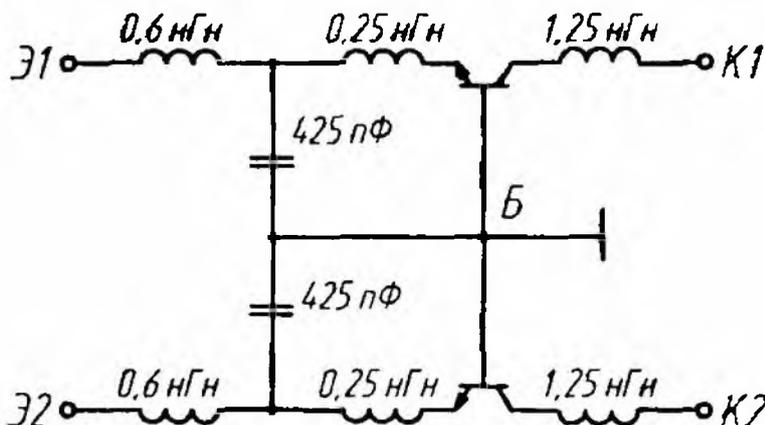
Коэффициент полезного действия в двухтактной схеме на частоте  $f = 500$  МГц при  $U_n = 45$  В,  $P_{вх} = 71,4$  Вт,  $t_{и} = 250$  мкс,  $Q = 10$ ,  $T_k \leq +40$  °С, не менее ..... 45%

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 5$ А, $f = 100$ МГц, не менее .....	3
Критический ток для каждого транзистора при $U_{кз} = 10$ В, на $f = 100$ МГц, не менее .....	18 А
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В, $I_3 = 0,5$ А, $f = 5$ МГц, не более .....	20 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 45$ В, не более .....	260 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$ , не более .....	3100 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 60$ В, не более .....	140 мА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кз} = 45$ В, не более .....	100 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более .....	100 мА

Примечание: для  $I_{кб0}$ ,  $I_{кзк}$ ,  $I_{эб0}$  приведены суммарные значения двух параллельно включенных транзисторов.

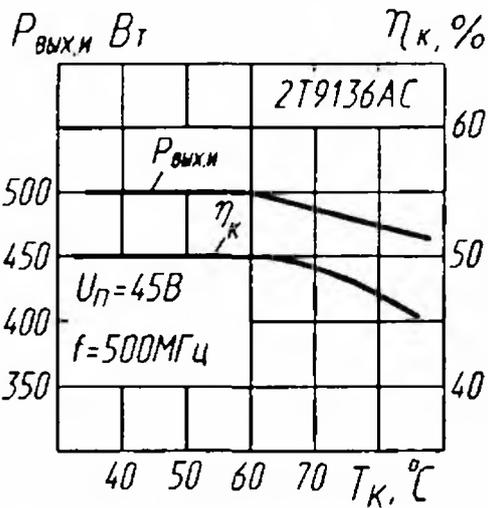
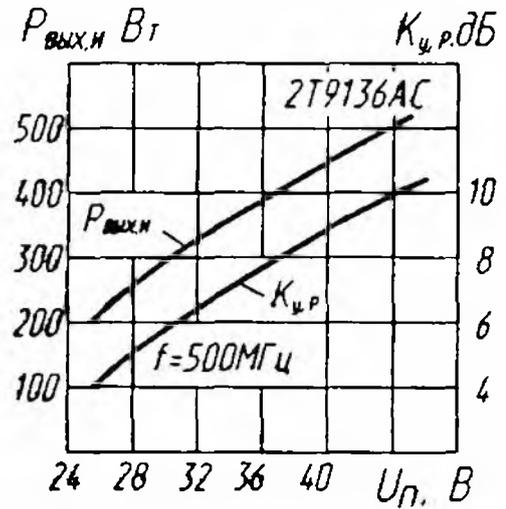
### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база .....	60 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	4 В
Импульсный ток коллектора для двух транзисторов при $t_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$ .....	30 А
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{и} = 250$ мкс, $Q = 10$ , $T_k = +60$ °С .....	250 Вт
Температура р-п перехода .....	+200 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_k = +125$ °С

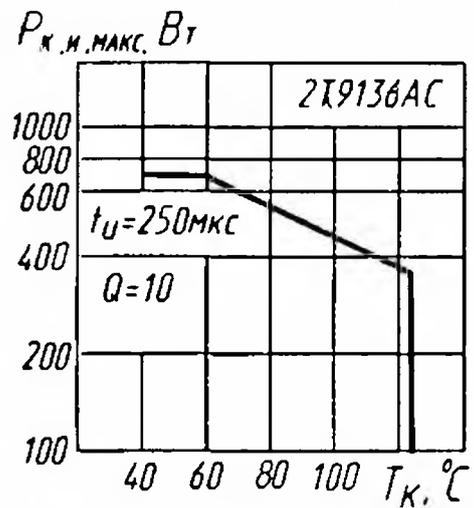


Принципиальная электрическая схема транзисторной сборки 2Т9136АС

Зависимости импульсной выходной мощности и коэффициента усиления от напряжения питания



Зависимости импульсной выходной мощности и коэффициента полезного действия коллектора от температуры корпуса



Зависимость максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса